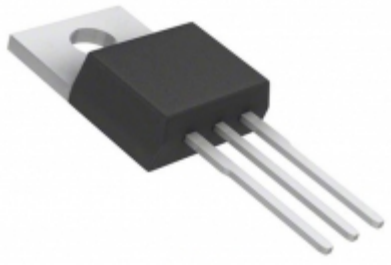








	<h2 style="color: red;">FQP7N80C</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP7N80C</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 6.6A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP7N80C.pdf 2.FQP7N80C.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 48671 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP7N80C
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 6.6A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	48671 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	167W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	6.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.9 Ohm @ 3.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1680pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube

FQP7N80C ist neu im Original, Suche FQP7N80C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP7N80C Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FQP7N80C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP7N65 FAIRCHILD FQP7N65 FAIRCHILD</p>	 <p>FQP7N65C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 7A TO-220</p>	 <p>FQP7N80C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6.6A TO-220</p>	 <p>FQP7N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6.6A TO-220</p>
 <p>FQP7P20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 7.3A TO-220</p>	 <p>FQP7P06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 7A TO-220</p>	 <p>FQP7N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6.6A TO-220</p>	 <p>FQP7P06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 7A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP6N40CF	↔ FQP6N40CF	⇒ FQP6N50C	D FQP6N50C	⇒ FQP6N60C
⊣ FQP6N60C	⊗ FQP6N80C	D FQP6N80C	⇒ FQP6N90C	⇒ FQP6N90C
⊗ FQP70N03L	⊣ FQP70N06	⊗ FQP70N06C	↔ FQP70N08	⇒ FQP70N08
D FQP70N10	⊗ FQP70N10	⊣ FQP7N10L	⊗ FQP7N10L	⇒ FQP7N20L
⇒ FQP7N20L	↔ FQP7N60C	⊗ FQP7N65C	⊣ FQP7N65C	⇒ FQP7N80C
↔ FQP85N06	⇒ FQP85N06	D FQP8N50C	⊗ FQP8N60C	⊣ FQP8N60C
⊗ FQP8N65C	D FQP8N80C	⇒ FQP8N80C	↔ FQP8N90C	⇒ FQP8N90C
⊣ FQP90N08	⊗ FQP90N08	↔ FQP90N10V2	⇒ FQP90N10V2	⇒ FQP9N08L
⊗ FQP9N08L	⊣ FQP9N25C	⊗ FQP9N25C	D FQP9N50C	⇒ FQP9N50C
↔ FQP9N65C	⊗ FQP9N90C	⊣ FQP9N90C	⊗ FQPF10N20	⇒ FQPF10N20

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited